

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

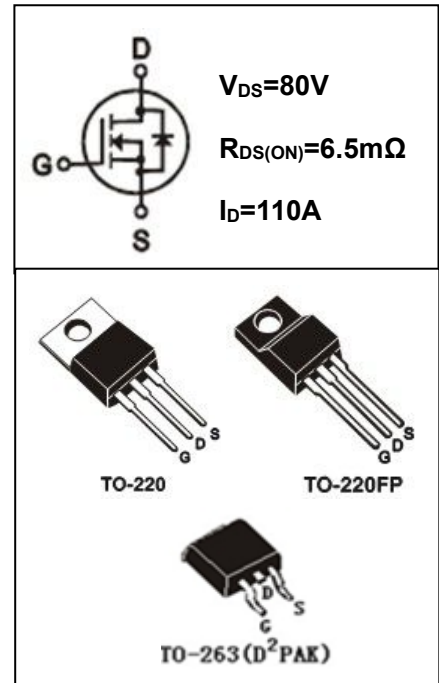
SIF110N080

- 特点：热阻低 导通电阻低 栅极电荷低，开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范
- FEATURES: ■LOW THERMAL RESISTANCE ■LOW $R_{DS(ON)}$ TO MINIMIZE CONDUCTIVE LOSS ■LOW GATE CHARGE FOR FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE ■RoHS COMPLIANT
- 应用：低压高频逆变电路 同步整流 开关应用
- APPLICATION: ■LOW VOLTAGE,HIGH FREQUENCY INVERTERS ■SYNCHRONOUS RECTIFICATION ■SWITCH APPLICATIONS

●最大额定值 (TC=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-220/263/220FP

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V_{DS}	80	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V_{GS}	±25	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C ①	I_D	110*	A
耗散功率 Total Power Dissipation ①	P_{tot}	200* FP:40	W
最高结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T_{STG}	-55-175	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E_{AS}	550	mJ



●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	80	86		V
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$ ③	2	3	4	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I_{DSS}	$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V$			1	μA
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS}=0$)	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V$			±100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=40A$ ③		6.5	8	mΩ
跨导 Forwad Transconductance	g_{FS}	$V_{DS}=25V, I_D=20A$ ③		80		S

●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
TO-220(FP)/263 条管装 /TUBE PACKING	SIF110N080 TO-220(FP)/263-TU	SIF110N080 TO-220(FP)/263-TU-HF
TO-263 编带装/TAPE & REEL PACKING	SIF110N080 TO-263-TR	SIF110N080 TO-263-TR-HF

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF110N080

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
输入电容 Input Capacitance	Ciss	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		3150		pF
输出电容 Output Capacitance	Coss			450		
反向传输电容 Reverse Transfer Capacitance	Crss			220		
导通延迟 Turn -On Delay Time	Td(on)	$V_{DD}=38V, I_D$ $=10A, R_L=3.8\Omega$ $V_{GS} = 10V, R_G=1\Omega$		20		ns
开启上升时间 Turn -On Rise Time	T_r			35		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	Td(off)			55		
关断下降时间 Turn -Off Fall Time	T_f			22		
栅极电荷 Total Gate Charge	Qg	$I_D = 80A, V_{DS} = 60V$ $V_{GS} = 10V$		80		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Qgs			17		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Qgd			31		nC
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j=25^\circ C, I_s=30A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.35	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	trr	$T_j=25^\circ C, I_s=10A$ $di/dt=100A/\mu s$ ③		37		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Qrr			58		nC

●热特性

●Thermal Characteristics

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX			单位 UNIT
		TO-220/263		TO-220FP	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	RthJC	0.63		3.13	°C/W
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	RthJA	62.5		62.5	°C/W

注释(Notes):

- ① 以最高结温为限制，基于 TO-220 封装形式，25°C 下本产品硅限电流 I_D 为 110A，封装限制电流 80A。
 I_D & P_D base on maximum allowable junction temperature, calculated upon TO-220 package type is limited to carry 80A at 25°C.
- ② 初始结温=25°C, $V_{DD} = 40V, V_G = 10V, L = 0.5mH, R_G = 25\Omega$ 。
Starting $T_j = 25^\circ C, V_{DD} = 40V, V_G = 10V, L = 0.5mH, R_G = 25\Omega$.
- ③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$
Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

N-沟道功率 MOS 管/ N-CHANNEL POWER MOSFET

SIF110N080

● 特性曲线

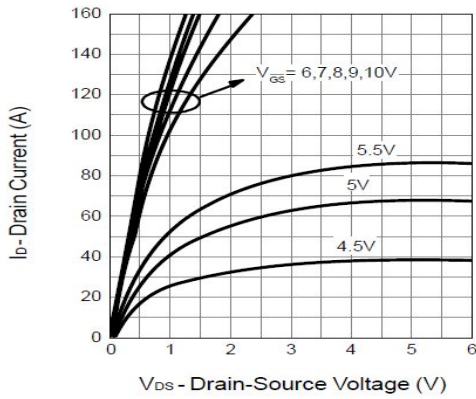


图 1 输出特性曲线, $T_c=25^\circ\text{C}$

Fig1 Typical Output Characteristics, $T_c=25^\circ\text{C}$

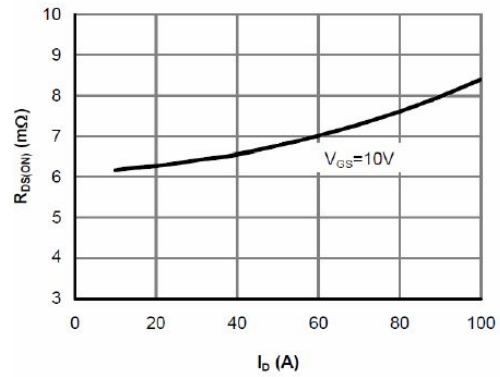


图 2 导通电阻与漏极电流的曲线

Fig2 Resistance V.S Drain Current

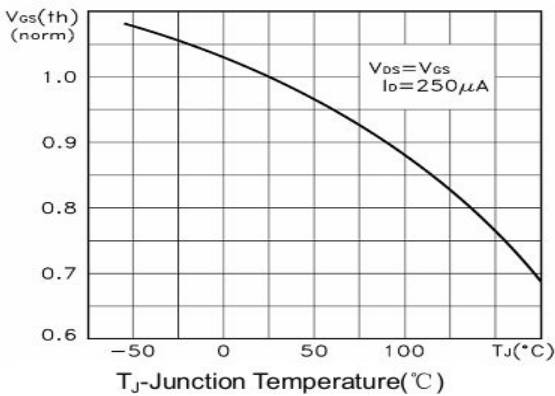


图 3 阈值电压与结温度曲线

Fig3 Threshold Voltage V.S Junction Temperature

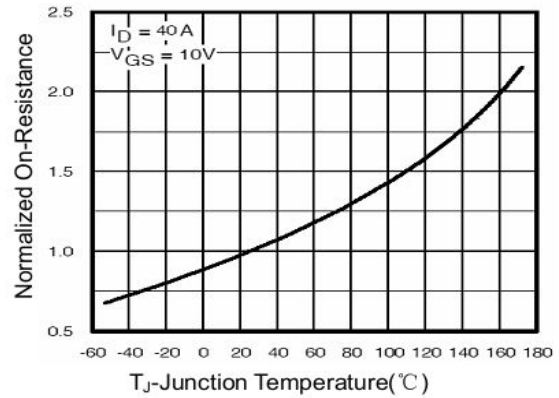


图 4 导通电阻与结温度曲线

Fig4 Resistance V.S Junction Temperature

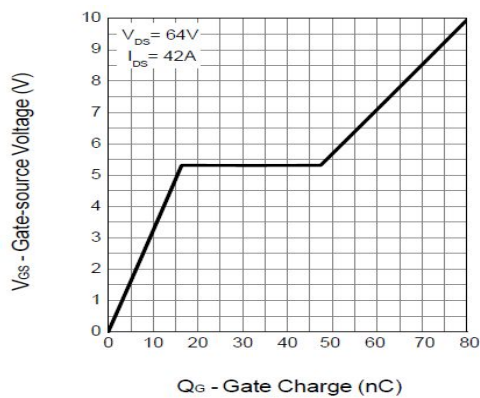


图 5 典型栅极电荷与栅源电压曲线

Fig5 Typical Gate Charge V.S Gate-to-Source Voltage

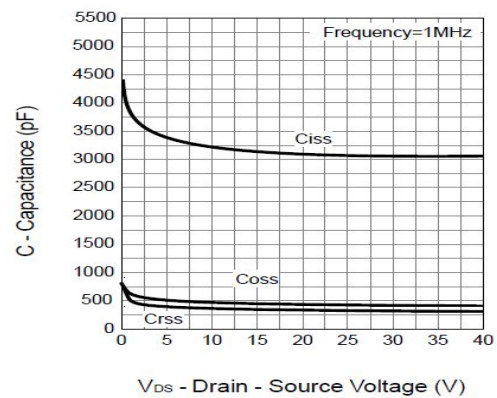


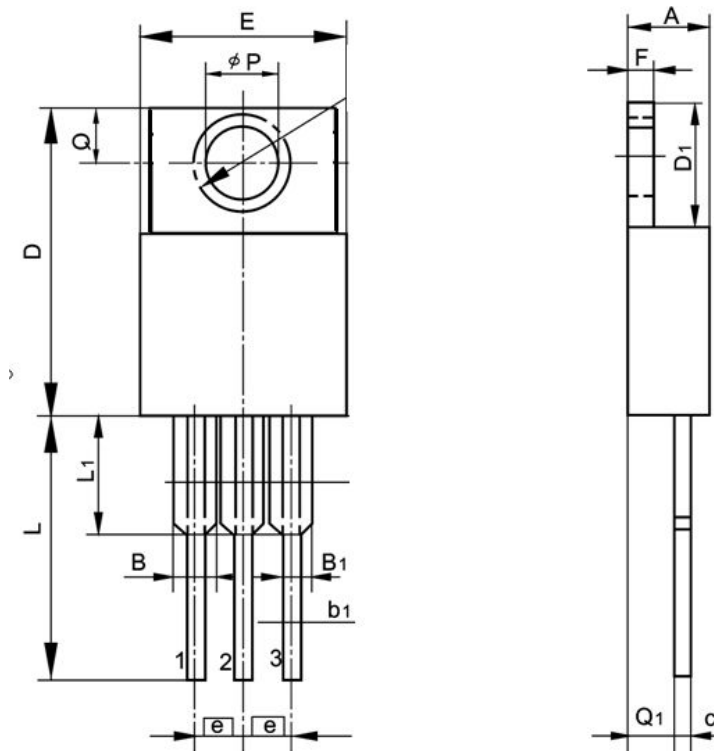
图 6.典型电容与漏源电压的曲线

Fig6 Typical Capacitance V.S Drain-to-Source Voltage

TO-220 封装机械尺寸 TO-220 MECHANICAL DATA

单位：毫米/UNIT: mm

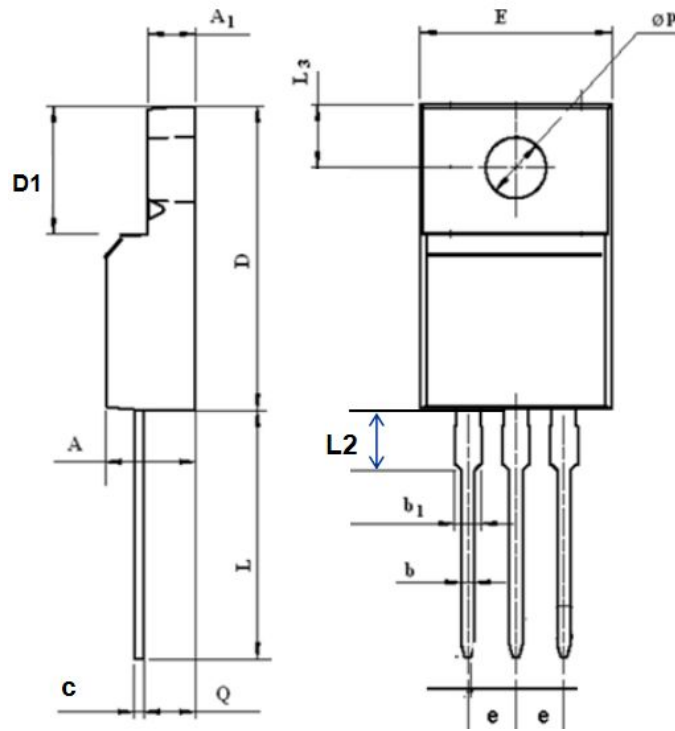
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.00		4.80	E	9.90		10.70
B	1.20		1.50	e		2.54	
B1	1.00		1.40	F	1.10		1.45
b1	0.65		1.00	L	12.50		14.50
c	0.35		0.75	L1	3.00	3.50	4.00
D	15.00		16.50	Q	2.50		3.00
D1	5.90		6.90	Q1	2.00		3.00
				φ P	3.60		3.90



TO-220FP 封装机械尺寸 TO-220FP MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.40		4.95	E	9.60		10.30
A ₁	2.30		2.90	e		2.54	
b	0.70		0.90	L	12.40		14.00
b ₁	1.18		1.45	L₂	2.30		2.60
c	0.40		0.70	L ₃	3.00		4.00
D	14.50		17.00	∅p	3.00		3.50
D1	6.10		9.00	Q	2.30		2.80

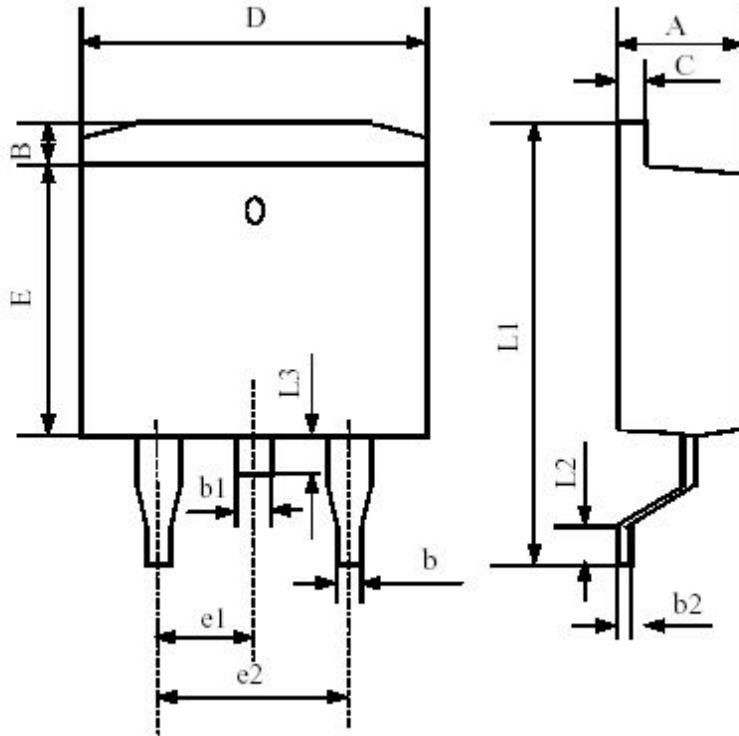


TO-263 封装机械尺寸

TO-263(D2PAK) MECHANICAL DATA

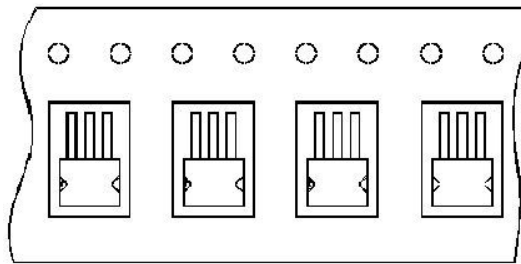
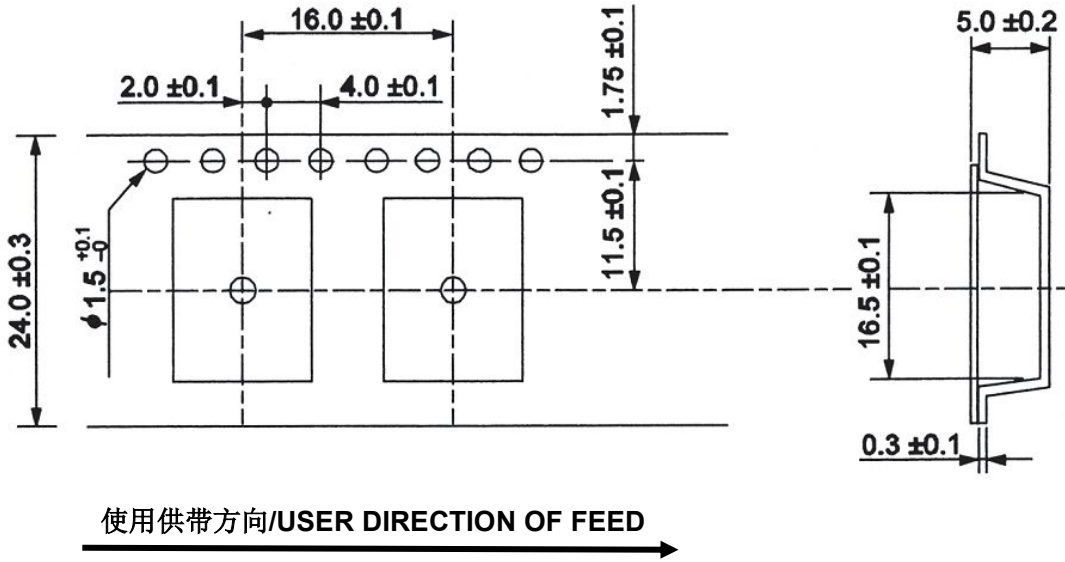
单位: 毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.42		4.72	E	8.99		9.29
B	1.22		1.32	e1	2.44		2.64
b	0.76		0.86	e2	4.98		5.18
b1	1.22		1.32	L1	15.19		15.79
b2	0.33		0.43	L2	2.29		2.79
C	1.22		1.32	L3	1.30		1.75
D	9.95		10.25				



TO-263 编带规格尺寸 TO-263 TAPE AND REEL DATA

单位:毫米/UNIT: mm



编带器件定位示意图/UNIT ORIENTATION